

第4回結晶工学講演会 一般講演プログラム

P01

RF マグネトロンスパッタリング法による N ドープ Cu_2O 薄膜の作製

上里田直弥¹, 石川博康^{1,2}

¹ 芝浦工業大学大学院理工学研究科, ² 次世代半導体人材育成センター

P02

RF スパッタリング法による $(\text{CuO})_x(\text{NiO})_{1-x}$ 薄膜の作製

青木航太郎¹, 石川博康^{1,2}

¹ 芝浦工業大学大学院理工学研究科, ² グリーンエレクトロニクス国際研究センター

P03

ミスト CVD 法による Al 添加 MgO 薄膜成長へ原料供給方法が与える影響

中島三四郎¹, 小川広太郎¹, 田中恭輔¹, 山口智宏¹, 本田 徹¹, 尾沼猛儀¹

¹ 工学院大学

P04

準安定相組成域の岩塩構造 MgZnO 混晶におけるウルツ鉱構造の配向性評価

田中恭輔¹, 小川広太郎¹, 山口智広¹, 本田 徹¹, 尾沼猛儀¹

¹ 工学院大学

P05

Hot-wall ミスト CVD 法により成長した MgO 薄膜中の不純物定量評価

小川広太郎¹, 田中恭輔¹, 山口智広¹, 本田 徹¹, 尾沼猛儀¹

¹ 工学院大学

P06

異なる Si ドーピング濃度で減圧ホットウォール MOVPE 成長した $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3(010)$ ホモエピタキシャル層の結晶性およびキャリア輸送特性評価

伊庭義騎¹, 吉永純也^{1,2}, 窪田翔海¹, 寺内悠真¹, 尾沼猛儀³, 東脇正高^{4,5}, 伴雄三郎⁶, 熊谷義直¹

¹ 東京農工大学大学院工学府, ² 大陽日酸株式会社, ³ 工学院大学,

⁴ 大阪公立大学大学院工学研究科, ⁵ 情報通信研究機構, ⁶ 大陽日酸 ATI 株式会社

P07

高キャリア濃度 OVPE-GaN の犠牲層応用に向けた電気化学エッチング特性の調査

横井創吾¹, 宇佐美茂佳¹, 今西正幸¹, 隅 智亮², 滝野淳一², 岡山芳央²,

横山正史³, 秦 雅彦⁴, 田中敦之⁵, 本田善央⁵, 天野 浩⁵, 丸山美帆子¹, 吉村政志⁶, 森 勇介¹

¹大阪大学大学院工学研究科, ²パナソニックホールディングス(株), ³住友化学(株),

⁴伊藤忠プラスチックス(株), ⁵名古屋大学未来材料・システム研究所, ⁶大阪大学レーザー科学研究所

P08

Na フラックス法におけるポイントシード結合方位が GaN 結晶転位分布に与える影響

佐々木 稜太郎¹, 今西 正幸¹, 村上 航介¹, 宇佐美 茂佳¹, 丸山 美帆子¹, 吉村 政志^{1,2}, 森 勇介¹

¹大阪大学大学院工学研究科, ²大阪大学レーザー科学研究所

P09

高温・高圧条件下の Na フラックス法 GaN 結晶成長において Ga 組成比がポイントシード上結晶の均一性に与える影響

山本彩佳¹, 田代知輝¹, 佐々木稜太郎¹, 鷲田将吾¹, 村上航介¹, 今西正幸¹,

宇佐美茂佳¹, 丸山美帆子¹, 吉村政志^{1,2}, 森 勇介¹

¹大阪大学大学院工学研究科, ²大阪大学レーザー科学研究所

P10

Na フラックス法における高温高圧条件を利用した PS 上 GaN 結晶成長の促進

田代知輝¹, 今西正幸¹, 村上航介¹,

宇佐美茂佳¹, 丸山美帆子¹, 吉村政志^{1,2}, 森 勇介¹

¹大阪大学大学院工学研究科, ²大阪大学レーザー科学研究所

P11

横型擬似位相整合を用いた光パラメトリック下方変換用 GaN 極性反転積層構造の設計

谷口貫太, 上田佳奈子, 上向井正裕, 谷川智之, 片山竜二

大阪大学大学院工学研究科

P12

Sc_xB_{1-x}N 混晶におけるバンドギャップエンジニアリング

河島 龍, 水野 斎, 松本公久, 太田優一

富山県立大学

P13

歪み SiGe/Ge 層のクラック周辺の歪み分布と選択的イオン注入によるクラック抑制

溝口稜太¹, 加藤恵太郎¹, 芝原夕夏¹, 相川茉由¹, 山田道洋¹, 浜屋宏平^{2,3}, 澤野憲太郎¹

¹ 東京都市大, ² 阪大基礎工 CSRN, ³ 阪大 OTRI スピン

P14

熱中性子検出を目的とした Ce 添加 CaF₂/LiF 共晶シンチレーターの組織構造およびシンチレーション特性の評価

松山朋旦^{1,2}, 鎌田 圭^{3,4}, 吉野将生^{2,3}, 村上力輝斗^{2,3}, 石澤 倫², 横田有為^{2,4}, 吉川 彰^{2,3,4}

¹ 東北大工, ² 東北大金研, ³ (株)C&A, ⁴ 東北大 NICHe

P15

歪み SiGe/Ge 多重量子井戸における発光の井戸厚・障壁厚依存性

相川茉由¹, 菊岡柊哉¹, 溝口稜太¹, 山田道洋¹, 浜屋宏平^{2,3}, 澤野憲太郎¹

¹ 東京都市大, ² 阪大基礎工 CSRN, ³ 阪大 OTRI スピン

P16

結晶・光閉じ込め・熱設計を統合した AlGaIn 系 UV-B レーザーダイオードによる 318 nm 室温 CW 発振

三宅倫太郎¹, 齋藤巧夢¹, 丸山竣大¹, 狩野祥吾¹, 佐々木祐輔¹, 神谷始音¹, 渡辺峻太¹, 宮本侑菜¹, 橘田直樹¹, 加藤晴也¹, 岩山章¹, 竹内哲也¹, 上山 智¹, 三宅秀人², 岩谷素顕¹

¹ 名城大学大学院理工学研究科, ² 三重大学大学院工学研究科

P17

低温成長 AlGaIn UV-B レーザーにおけるキャリア注入効率 50%の達成

齋藤巧夢¹, 三宅倫太郎¹, 丸山竣大¹, 佐々木祐輔¹, 狩野祥吾¹, 加藤晴也¹, 橘田直樹¹, 渡辺峻太¹, 宮本侑菜¹, 神谷始音¹, 岩山 章¹, 三宅秀人², 上山 智¹, 竹内哲也¹, 岩谷素顕¹

¹ 名城大学大学院理工学研究科, ² 三重大学大学院工学研究科